PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-097676

(43)Date of publication of application: 08.04.1997

(51)Int.CI.

H05B 33/14 C09K 11/06 H05B 33/20

(21)Application number: 07-254843

(71)Applicant: TOYO INK MFG CO LTD

(22)Date of filing:

02.10.1995

(72)Inventor: ONIKUBO SHIYUNICHI

OKUTSU SATOSHI

(5.4) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance age-based stability by using a ternary alloy composed of the combination of specific metal having a different work function for the cathode of an organic EL element to prevent the oxidation of the cathode.

SOLUTION: A compound 1 expressed by the following chemical structure is deposited by vacuum evaporation on a cleaned glass plate with an ITO electrode to obtain a hole injection layer having a film thickness, for instance, of 50nm. Thereon, Mg for a metal element A, AI for a metal element B and Zn for a metal element C are simultaneously evaporated from the respective evaporation sources, and a cathode comprising an alloy of Mg:AI:Zn=10:1:1 having a film thickness of 200nm is formed by common evaporation. The positive hole injection layer, a light emitting layer and the cathode are deposited by evaporation under the conditions that vacuum is 10-6torr and the temperature of a substrate is a room temperature. By an organic EL element formed, for instance, yellow green luminescence having luminescent brightness of 220cd/m2 is obtained at a DC voltage of 5V, and luminous efficiency is 2.11m/W. Therefore, the oxidation of a cathode can be prevented to enhance stability with lapse of time.

LEGAL STATUS

[[late of request for examination]

01.07.2002

[[]ate of sending the examiner's decision of

07.06.2005

rejection]

[kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[L'ate of final disposal for application]

[F'atent number]

[[rate of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Liate of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Liate of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-97676

(43)公開日 平成9年(1997)4月8日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
H05B 33/14			H 0 5 B 33/14		
C09K 11/08		9280-4H	C 0 9 K 11/06	Z	
H 0 5 B 33/20			H 0 5 B 33/20	·	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特願平7-254843	(71)出顧人	000222118	
			東洋インキ製造株式会社	
(22)出顧日	平成7年(1995)10月2日		東京都中央区京橋2丁目3番13号	
		(72)発明者	鬼久保 俊一	
			東京都中央区京橋二丁目3番13号	東洋イ
			ンキ製造株式会社内	
		(72)発明者	奥津 聡	
			東京都中央区京橋二丁目3番13号	東洋イ
		·	ンキ製造株式会社内	
•				
		1 '		

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス案子

(57)【要約】

【課題】 環境に対する経時安定性の高い陰極を使用した、発光劣化が少なく信頼性の高い有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。

【解決手段】 陽極および陰極間に発光層もしくは発光層を含む有機化合物薄膜層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子において、陰極が仕事関数4.0 e V未満であるアルカリ金属、アルカリ土類金属、または希土類元素のうちから選ばれる1種の金属元素(A)と、仕事関数4.0 e V以上のものから選ばれる1種の金属元素(B)と、上記で選ばれなかった金属元素であって、Y、Gd、Nd、Sc、La、Zn、Mg、Zr、Cd、In、Mn、Pb、V、Ga、Ti、Bi、Sn、Crから選ばれる1種の金属元素(C)からなる3元合金であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極および陰極間に発光層もしくは発光層を含む有機化合物薄膜層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子において、陰極が仕事関数4.0 e V未満であるアルカリ金属、アルカリ土類金属、または希土類元素のうちから選ばれる1種の金属元素(A)と、仕事関数4.0 e V以上のものから選ばれる1種の金属元素(B)と、上記で選ばれなかった金属元素であって、Y、Gd、Nd、Sc、La、Zn、Mg、Zr、Cd、In、Mn、Pb、V、Ga、Ti、Bi、Sn、Crから選ばれる1種の金属元素(C)からなる3元合金であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 仕事関数4.0 e V以上のものとして選ばれる金属元素(B)がIn, Pb, Ag, Al, Bi, Sn, Sb, Cu, Co, Au, Ni, Pd, Ptから選ばれる1種の金属元素である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 金属元素(C)として選ばれたものの3元合金中での割合が0.1~50at.%である請求項 201または2に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平面光源や表示に使用される有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子に関するものであり、特に発光劣化の少ない長寿命発光素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用したEL素子は、固体発光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が有望視され、多くの開発が行われている。一般にELは、発光層および該層をはさんだ一対の対向電極から構成されている。発光は、両電極間に電界が印加されると、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入される。さらに、この電子が発光層において正孔と再結合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギーを光として放出する現象である。

【0003】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。また、特性劣化も若しく実用化には至っていなかった。近年、10V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機EL素子が報告され、関心を集めている(アブライド・フィジクス・レターズ、51巻、913ページ、1987年参照)。この方法では、金属キレート錯体を蛍光体層、アミン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発光を得ており、6~7Vの直流電圧で輝度は1000cd/m²、最大発光効率は1.51m/Wを達成して、実用領域に近い性能を持っている。しかしながち、

現在までの有機EL素子は、構成の改善により発光強度 は改良されつつあるが、繰り返し使用時、および大気中 での長期保存時の安定性に劣るという大きな問題があ る。

【0004】発光輝度、効率を改善する手段の1つとして、電子の注入効率を向上させるために仕事関数の小さい金属やそれを含む合金を陰極として用いることが行われている。例えば、特開平2-15595号公報には主としてMg合金を用いた例が、特開平4-212287号公報、特開平5-121172号公報、特開平5-159882号公報、特開平5-198380号公報にはLi合金を用いた例が開示されている。しかし、これらの方法では仕事関数の小さい金属、すなわち酸化され易い金属を含むため、大気中の水分や酸素により陰極の劣化が進み、輝度低下や駆動電圧の上昇、さらにはダークスポットと呼ばれる非発光部分の形成と増大が、経時駆動中あるいは発光させずに大気下に放置した場合にも観測される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、発光輝度、駆動電圧などの素子初期特性を維持しつつ、繰り返し使用時での安定性の優れた有機EL素子の提供にある。本発明者らが鋭意検討した結果、仕事関数の異なる特定の金属の組み合わせからなる3元合金を陰極に使用した有機EL素子は経時安定性に優れていることを見いだし本発明をなすに至った。

[0006]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、陽極および陰極間に発光層もしくは発光層を含む有機化合物薄
随層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子において、陰極が仕事関数4.0 e V未満であるアルカリ金属、アルカリ土類金属、または希土類元素のうちから選ばれる1種の金属元素(A)と、仕事関数4.0 e V以上のものから選ばれる1種の金属元素(B)と、上記で選ばれなかった金属元素であって、Y、Gd、Nd、Sc、La、Zn、Mg、Zr、Cd、In、Mn、Pb、V、Ga、Ti、Bi、Sn、Crから選ばれる1種の金属元素(C)からなる3元合金であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子に関するものである。

【0007】 ことで、仕事関数は金属元素やその他の材料の形態や測定方法、条件により値が大きく異なることが多く、報告されている値も文献により異なる。本発明では、主な金属元素の仕事関数は化学便覧改訂3版(日本化学会編)基礎編IIの493ページに記載されている値を採用した。これらの中には特開平2-15595号公報に記載されている値と大きく異なるものもあるが、本発明における金属元素の分類、選択にはこれらの文献値に限定されない。

50 【0008】陰極における金属元素(A)および(B)

の役割は、従来の2元合金と同様、(A)が主に電子の 注入効率を向上させることによる駆動電圧の低下、およ び発光効率の向上であり、(B)が主に(A)の安定化 や有機層への密着性の向上である。これに第3成分とし て加えられる(C)は、(A)を化学的に安定化させ る、(A)の仕事関数を維持する、または合金としての 仕事関数をさらに低下させる、合金の緻密性を向上させ たり合金組成を均一化することで合金の酸化を抑制す る、あるいは(C)の酸化被膜を表面に作ることで合金 内部への水分や酸素の浸透を防止するなどの効果のうち の1つまたは2つ以上を有する。これらのうちどの効果 が発現するかは(C)の種類にも拠るが、同じ(C)で あっても(A) および(B) の種類により異なることが ある。いずれの効果の場合も(C)は最終的に陰極の性 質、特に(A)の良好な特性を活かしたまま、陰極の経 時的安定性を増加させることに寄与する。

【0009】本発明において、仕事関数4.0eV未満 である金属元素(A)としては、具体的にはCs(1. 95), Rb (2. 16), K (2. 28), Na (2.36), Li(2.93) などのアルカリ金属、 Ba (2. 52), Sr. Ca (2. 9), Mg (3. 66) などのアルカリ土類金属、Eu (2.5), Yb (2.6), Sm (2.7), Ce (2.9), Er (2. 97), Gd (3. 1), Y (3. 1), Nd (3.2), La(3.5), Sc(3.5)などの希 土類元素がある。ととで、括弧中の値は前出の化学便覧 に記載されているもの(単位:eV)である。Srにつ いてはこの文献には記載がなかった。

【0010】本発明において、仕事関数4.0eV以上 である金属元素(B)は多種類あるが、この中でも典型 30 金属元素であるIn (4.09), Pb (4.25), Al (4.28), Bi (4.34), Sn (4.4 2), Sb(4.55)、遷移金属元素であるAg (4. 26), Cu (4. 65), Co (5. 0), A u (5. 1), Ni (5. 15), Pd (5. 55), Pt (5.64) が好ましい。

【0011】本発明において、金属元素(C)として は、希土類元素であるY(3.1), Gd(3.1), Nd (3, 2), Sc (3, 5), La (3, 5), 典 型金属元素である2n(3.63), Mg(3.6 6), Cd (4. 08), In (4. 09), Pb (4.25), Ga (4.3), Bi (4.34), S n (4.42)、遷移金属元素であるZr (4.0 5), Mn (4. 1), V (4. 3), Ti (4. 3 3), Cr(4.5) であるが、これらの金属元素の仕 事関数は括弧中に示した通り3.0eV以上4.5eV 以下の範囲にある。ととで、(C)として選ぶことので きる金属元素は、金属元素(A)または(B)としても 選ぶことができるが、どちらの群の金属元素として選ば れるかは、3元合金における金属元素の組み合わせと合 50 して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の透光性を

金中でのそれぞれの金属元素の役割によって確定するも ので、最初から限定されている訳ではない。また、3元 合金における金属元素の組み合わせにおいて、金属元素 (C)の仕事関数の値が金属元素(A)と(B)の仕事 関数の値の間にある必要は必ずしもなく、(A)と (C)、あるいは(B)と(C)の間に数値の逆転があ ってもかまわない。

【0012】本発明において、金属元素(C)より選ば れたものの3元合金中での割合は0.1~50at.% であることが好ましい。ここでat. %とは原子比にお ける百分率である。0.1%未満であると(C)を含有 する効果の発揮が期待できず、50%を越えると効果の さらなる向上が期待できない上に、他の特性を著しく低 下させる場合もある。

【発明の実施の形態】

【0013】有機EL素子は、陽極と陰極間に一層もし くは多層の有機薄膜を形成した素子である。一層型の場 合、陽極と陰極との間に発光層を設けている。発光層 は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注入した 20 正孔もしくは陰極から注入した電子を発光材料まで輸送 させるために正孔輸送材料もしくは電子輸送材料を含有 しても良い。多層型は、(陽極/正孔注入層/発光層/ 陰極)、(陽極/発光層/電子注入層/陰極)、(陽極 /正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)の多層構成 で積層した有機EL素子がある。

【0014】有機EL素子は、多層構造にすることによ り、正孔と電子の発光層中での再結合を効率的に起とさ せることが可能になり、さらにクエンチングによる輝度 や寿命の低下を防ぐことができる。また、必要があれ ば、発光材料、ドービング材料、キャリア輸送を行う正 孔輸送材料や電子輸送材料を二種類以上組み合わせて使 用することも出来る。また、正孔注入層、発光層、電子 注入層は、それぞれ二層以上の層構成により形成されて も良く、正孔もしくは電子が効率よく電極から注入さ れ、層中で輸送される素子構造が選択される。

【0015】有機EL素子の陽極に使用される導電性材 料は、4.0eVより大きな仕事関数を持つものが好適 であり、炭素、アルミニウム、パナジウム、鉄、コバル ト、ニッケル、タングステン、銀、金、白金、パラジウ 40 ム等およびそれらの合金、ITO基板、NESA基板に 使用される酸化スズ、酸化インジウム等の酸化金属、さ ちにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹 脂が用いられるが、これらに限定されるものではない。 陽極は、必要があれば二層以上の層構成により形成され ていても良い。

【0016】有機EL素子では、効率良く発光させるた めに、少なくとも一方は素子の発光波長領域において充 分透明であることが望ましい。また、基板も透明である ととが望ましい。透明電極は、上記の導電性材料を使用 確保するように設定する。発光面の電極は、光透過率を 10%以上にすることが望ましい。基板は、機械的、熱 的強度を有し、透明であれば限定されるものではない が、例示すると、ガラス基板、ポリエチレン板、ポリエ ーテルサルフォン板、ポリプロピレン板等の透明性樹脂 があげられる。

【0017】本発明に係わる有機EL素子の有機各層の 形成は、真空蒸着、スパッタリング等の乾式成膜法やス ピンコーティング、ディッピング等の湿式成膜法のいず れの方法を適用することができる。 膜厚は特に限定され 10 るものではないが、各層は適切な膜厚に設定する必要が ある。膜厚が厚すぎると、一定の光出力を得るために大 きな印加電圧が必要になり効率が悪くなる。膜厚が薄す ぎると、薄膜中にピンホール等が発生して、電界を印加 しても充分な発光輝度が得られない。 通常の膜厚は5 n mから10μmの範囲が適しているが、10nmから 0. 2μmの範囲がさらに好ましい。

【0018】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料 を、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等 の適切な溶媒に溶解または分散して薄膜を形成するが、 その溶媒はいずれであっても良い。また、いずれの薄膜 においても、成膜性向上、膜のピンホール防止等のため 適切な樹脂や添加剤を使用しても良い。使用の可能な樹 脂としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリア リレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、 ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチ ルアクリレート、セルロース等の絶縁性樹脂、ポリーN - ビニルカルバゾール、ポリシラン等の光導電性樹脂、 ポリチオフェン、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げる 外線吸収剤、可塑剤等を挙げるととができる。

【0019】本発明の有機EL素子に使用できる発光材 料またはドーピング材料としては、アントラセン、ナフ タレン、フェナントレン、ピレン、テトラセン、コロネ ン、クリセン、フルオレセイン、ペリレン、フタロペリ レン、ナフタロペリレン、ペリノン、フタロペリノン、 ナフタロペリノン、ジフェニルブタジエン、テトラフェ ニルブタジエン、クマリン、オキサジアゾール、アルダ ジン、ピスペンゾキサゾリン、ピススチリル、ピラジ ン、シクロペンタジエン、キノリン金属錯体、アミノキ 40 ノリン金属錯体、ベンゾキノリン金属錯体、イミン、ジ フェニルエチレン、ピニルアントラセン、ジアミノカル パゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシア ニン、イミダゾールキレート化オキシノイド化合物、キ ナクリドン、ルブレン等およびそれらの誘導体がある が、これらに限定されるものではない。

【0020】正孔翰送材料としては、正孔を翰送する能 力を持ち、発光層または発光材料に対して優れた正孔注 入効果を有し、発光層で生成した励起子の電子注入層ま たは電子輸送材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の 優れた化合物が挙げられる。具体的には、フタロシアニ ン系化合物、ナフタロシアニン系化合物、ポルフィリン 系化合物、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾ ール、イミダゾロン、イミダゾールチオン、ピラゾリ ン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オキサゾ ール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾ ン、ポリアリールアルカン、スチルベン、ブタジエン、 ベンジジン型トリフェニルアミン、スチリルアミン型ト リフェニルアミン、ジアミン型トリフェニルアミン等 と、それらの誘導体、およびボリビニルカルパゾール、 ポリシラン、導電性高分子等の高分子材料等があるが、 とれらに限定されるものではない。

【0021】電子輸送材料としては、電子を輸送する能 力を持ち、発光層または発光材料に対して優れた電子注 入効果を有し、発光層で生成した励起子の正孔注入層ま たは正孔輸送材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能の 優れた化合物が挙げられる。例えば、フルオレノン、ア ントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオピランジオ キシド、オキサジアゾール、チアジアゾール、テトラゾ ール、ペリレンテトラカルボン酸、フレオレニリデンメ タン、アントラキノジメタン、アントロン等とそれらの 誘導体があるが、これらに限定されるものではない。ま た、正孔輸送材料に電子受容物質を、電子輸送材料に電 子供与性物質を添加して増感させることもできる。

【0022】陰極の製膜法としては、抵抗加熱蒸着、電 子ピーム蒸着、直流スパッタ、RFスパッタ、イオンプ レーティングなどの方法が挙げられる。抵抗加熱蒸着は 装置の簡便さもあって、比較的低温で蒸発する金属の場 合には非常に好適である。比較的髙温で蒸発する金属を ことができる。また、添加剤としては、酸化防止剤、紫 30 用いる時には、電子ビーム蒸着やスパッタ法がより好ま しい。蒸着源ないしはスパッタリングターゲットとして は、方法に応じて、金属単体であっても、合金であって もかまわない。しかし、抵抗加熱蒸着では、1種あるい は2種類の合金からそれぞれの金属を所望の比率で同時 に蒸発させるととは非常に困難なため、3つの蒸着源を 用いて、3元同時蒸着をすることが好ましい。ただし、 Li等の仕事関数の特に小さい金属は、空気中において 非常に不安定なため単体からの蒸着がやや難しいので、 これらの低仕事関数金属と同時に蒸発しない高沸点の金 属との合金から低仕事関数金属のみを蒸発させることが より好ましい。また、スパッタ法では、Liなどの単体 はターゲットを作成することが難しいので、合金ターゲ ットを作成し、比較的元の合金ターゲットに近い組成の 製膜が可能なRFスパッタで行うのがより好ましい。

> 【0023】陰極として製膜される合金は、必ずしもき ちんとした結晶状態や金属間化合物を形成している必要 はなく、十分な効果が発揮できるのであればいわゆる固 溶体と呼ばれるアモルファス状態でも良い。

> 【0024】本発明は、陰極の安定性あるいは他の特性 をさらに改善するために、さらにもう一種以上の金属成

分を加えることにより、4元以上の合金にすることを妨 げない。また、陰極は必要に応じて二層以上の金属また は合金により構成されても良く、層の下部と上部でその 組成や成分比率が連続的に変化しても良い。

【0025】陰極をさらに安定化させるために、水分や 酸素を透過しにくい、これらと反応しにくい、物理的、 化学的に安定な金属または合金を陰極の上に製膜しても 良い。これらの金属または合金は、陰極を形成する金属 成分のうちの1種または2種から選んでもよいし、全く 別の金属成分より形成されても良い。また、水分や酸素 10 に対するバリア性のさらに高い絶縁性の酸化物や窒化物 を陰極を覆うように形成しても良い。

【0026】本発明により得られた有機EL素子の、温 度、湿度、雰囲気等に対する安定性のさらなる向上のた めに、素子の表面に封止フィルムや封止樹脂等で保護層 を設けたり、シリコンオイル等を封入して素子全体を保 護するととも可能である。

【0027】以上のように、本発明では、有機EL索子 の陰極に仕事関数の異なる特定の金属の組み合わせから なる3元合金を用いたため、陰極の酸化を防止し、経時 20 安定性を高くすることが可能になった。また、この素子 は熱や電流に対しても非常に安定であり、さらには、低 電圧で実用的に使用可能な発光輝度が得られるので、従 来まで大きな問題であった経時での劣化、発光時間を大 幅に向上させ、有機EL素子の寿命向上に役立てること ができた。

【0028】本発明の有機EL素子は、壁掛けテレビ等 のフラットパネルディスプレイや、平面発光体として、* * 複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイや計器 類等の光源、表示板、標識灯等へ応用が考えられ、その 工業的価値は非常に大きい。

8

[0029]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づき、さらに詳細 に説明する。

【0030】実施例1

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、下記化学構造で 示される化合物(1)を真空蒸着して、膜厚50nmの 正孔注入層を得た。次いで、トリス(8-ヒドロキシキ ノリン) アルミニウム錯体を発光材料として真空蒸着し て膜厚50nmの発光層を作成した。その上に、金属元 素(A)としてMg、金属元素(B)としてA1、金属 元素(C)としてZnをそれぞれの蒸着源から同時に蒸 発させ、共蒸着を行うことによりMg:A1:Zn=1 0:1:1の合金で膜厚200nmの膜厚の陰極を形成 した。正孔注入層、発光層および陰極は、10-6Tor rの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。との ようにして作成した有機EL素子は、直流電圧5Vで発 光輝度220cd/m³の黄緑色発光が得られ、発光効 率は2. 1 l m/Wであった。この素子を特に封止をせ ずに、初期輝度100cd/m'で定電流駆動を続けた ところ、500時間後に65cd/m² までしか低下し なかった。またダークスポットも殆ど見られなかった。 また、大気下に1000時間放置後、発光させたとと ろ、ダークスポットは見られず均一な発光を示した。 【化1】

化合物(1)

【0031】実施例2~22

陰極として表1の組成の合金を使用する以外は、実施例 1と同じ方法で有機EL索子を作成して、直流電圧5V での発光輝度、初期100cd/m² で定電流駆動を続 けた時の、500時間後の輝度を測定した。結果を表1

40 に示す。なお、Liを蒸着する場合はLi:Al=1: 1の合金を、Smを蒸着する場合はSm:Co=1:5 の合金を蒸着源として使用し、LiまたはSmのみを蒸 発させた。

[0032]

【表1】

10

実施例	合金組成および比率 A: B: C		500時間後の輝度 (初期100cd/m²)
2	Mg Al Mn		
	10: 1: 1	. 200	70
3	Mg Ag Zn		
	9: 1: 2	250	60
4	Mg Ag In		
	17: 1: 2	280	ė 5
5	Li Al Mg		
	3: 1: 6	310	60
6	Li Al In		
	4: 2: 4	320	5 5
7	Li In Zn		
	1: 8: 3	300	60
8	Sm Al Mn		
	4: 5: 1	270	5 5
9.	Li Al Cr		
	2:90: 8	210	75 ·
10	Li In Sn		
	1:80:19	180	80
1 1	Yb Al Zn		
	5: 2: 3	290	70
12	Li Sb La		
	15:50:35	210	85

[0033]

実施例			500時間後の輝度 (初期100cd/m²)
13	Ca Bi Cd	•	
	20:78: 2	330	80
14	Mg Pb In		
	4: 1: 5	2.80	5 5
15	Sm Co Gd		
	15:84: 1	230	65
16	Ca Sn Nd		•
	40:55: 5	240	.60
1 7	Yb Pt Pb		
18	3: 2: 5	190	85
10	Mg Ag Bi 8: 1: 1	210	7.0
19	Mg Cu Sc	210	70
	7: 1: 2	180	75
20	Sm Pd Ga	100	7.5
	4: 2: 4	250	6 5
21	Mg Ni V		
	6: 2: 2	170	60
22	Mg Au Sn		
	8: 1: 1	220	70

【0034】実施例23 洗浄したITO電極付きガラス板上に、N, N'ー(4 ーメチルフェニル) -N, N'- (4-n-ブチルフェ 50 れぞれ50nm真空蒸着した。その上に、Mg:Al:

ニル) ーフェナントレンー9、10一ジアミン、トリス (8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体の願にそ 10

Zn=7:1:2で混合した合金で膜厚200nmの電 極を形成して有機EL素子を得た。各層は、10-9 To r r の真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。と の素子は、直流電圧5 Vで300 c d/m¹ の黄緑色発 光が得られ、発光効率は1.91m/Wであった。この 素子を特に封止をせずに、初期輝度100cd/m'で 定電流駆動を続けたところ、500時間後に60cd/ m' までしか低下しなかった。またダークスポットも殆 ど見られなかった。また、大気下に1000時間放置 後、発光させたところ、ダークスポットは殆ど見られな かった。

【0035】実施例24

洗浄した I TO電極付きガラス板上に、化合物(1)を クロロホルムに溶解分散させ、スピンコーティングによ り膜厚50nmの正孔注入層を得た。次いで、発光層と してトリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯 体を50nm真空蒸着した。その上に、Mg:Ag:M n=9:1:1で混合した合金で膜厚200nmの電極 を形成して有機EL素子を得た。発光層および陰極は、 10-*Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸 20 下しなかった。またダークスポットも見られなかった。 着した。との素子は、直流電圧5Vで280cd/m² の黄緑色発光が得られ、発光効率は2.41m/Wであ った。この素子を特に封止をせずに、初期輝度100 c d/m² で定電流駆動を続けたところ、500時間後に 75 c d/m² までしか低下しなかった。またダークス ボットも殆ど見られなかった。また、大気下に1000 時間放置後、発光させたところ、ダークスポットは見ら れず均一な発光を示した。

【0036】実施例25

洗浄した ITO電極付きガラス板上に、実施例24と同 様に正孔注入層、発光層を形成した。その上に、Li: In: Zn=3:3:4で混合した合金で膜厚200n mの電極を形成して有機EL素子を得た。発光層および 陰極は、10⁻⁶ Torrの真空中で、基板温度室温の 条件下で蒸着した。との素子は、直流電圧5 Vで200 cd/m'の黄緑色発光が得られ、発光効率は2.51 m/Wであった。この素子を特に封止をせずに、初期輝 度100cd/m'で定電流駆動を続けたところ、50 0時間後に70cd/m' までしか低下しなかった。ま たダークスポットも殆ど見られなかった。また、大気下 に1000時間放置後、発光させたところ、 ダークスポ ットは全く見られず均一な発光を示した。

【0037】実施例26

洗浄した I TO電極付きガラス板上に、実施例 1 と同様 に正孔注入層、発光層を10-1Torrの真空中で、基 板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。その上 に、Mg:Ag:Zn=13:1:2の面積比で分割さ れたターゲットを用いて、RFスパッタ法によりArガ 以下、0.5kWの出力で膜厚200nmの合金薄膜の 電極を形成して有機とし紫子を得た。この紫子は、直流 50

電圧5Vで230cd/m²の黄緑色発光が得られ、発 光効率は2.41m/Wであった。この素子を特に封止 をせずに、初期輝度100cd/m²で定電流駆動を続 けたところ、500時間後に70cd/m² までしか低 下しなかった。またダークスポットも殆ど見られなかっ た。また、大気下に1000時間放置後、発光させたと ころ、ダークスポットは見られず均一な発光を示した。 [0038] 実施例27

12

洗浄した I T〇電極付きガラス板上に、実施例1と同様 に正孔注入層、発光層を10°Torrの真空中で、基 板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。その上 に、Li:Al:Y=5:85:10で予め形成された 合金ターゲットを用いて、RFスパッタ法によりAェガ ス下、0.5kWの出力で膜厚200nmの合金薄膜の 電極を形成して有機EL素子を得た。との素子は、直流 電圧5 Vで220 c d/m²の黄緑色発光が得られ、発 光効率は2.31m/Wであった。との素子を特に封止 をせずに、初期輝度100cd/m'で定電流駆動を続 けたところ、500時間後に80cd/m² までしか低 また、大気下に1000時間放置後、発光させたとこ ろ、ダークスポットは全く見られず均一な発光を示し た。

【0039】実施例28

洗浄した ITO電極付きガラス板上に、実施例1と同様 に正孔注入層、発光層を10-6Torrの真空中で、基 板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。その上 に、Li:Ni:Zr=1:6:3で予め形成された合 金ターゲットを用いて、RFスパッタ法によりAェガス 下、0.5kWの出力で膜厚200nmの合金薄膜の電 極を形成して有機EL素子を得た。との素子は、直流電 圧5Vで180cd/m³の黄緑色発光が得られ、発光 効率は2.51m/₩であった。この素子を特に封止を せずに、初期輝度100cd/m²で定電流駆動を続け たところ、500時間後に85cd/m² までしか低下 しなかった。またダークスポットも見られなかった。ま た、大気下に1000時間放置後、発光させたところ、 ダークスポットは全く見られず均一な発光を示した。

[0040] 実施例29

洗浄した IT〇電極付きガラス板上に、実施例1と同様 に正孔注入層、発光層を10-6Torrの真空中で、基 板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。その上 に、Li:Al:Ti=3:70:27で予め形成され た合金ターゲットを用いて、RFスパッタ法によりAr ガス下、0.5k型の出力で膜厚200nmの合金薄膜 の電極を形成して有機EL索子を得た。との素了は、直 流電圧5 Vで200 c d/m²の黄緑色発光が得られ、 発光効率は2.21m/Wであった。この素子を特に封 止をせずに、初期輝度100cd/m゚ で定電流駆動を 続けたところ、500時間後に80cd/m' までしか 低下しなかった。またダークスポットも見られなかった。また、大気下に1000時間放置後、発光させたと とろ、ダークスポットは全く見られず均一な発光を示した。

【0041】比較例1

洗浄したITO電極付きガラス板上に、実施例1と同様に正孔注入層、発光層を形成した。その上に、Mg: In=10:1で混合した合金で膜厚200nmの電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10-*Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。この素子は、直流電圧5Vで230cd/m²の黄緑色発光が得られ、発光効率は2.21m/Wであった。この素子を特に封止をせずに、初期輝度100cd/m²で定電流駆動を続けたところ、500時間後には発光面の70%以上がダークスポットに覆われ、輝度も10cd/m²以下までに低下してしまった。また、大気下に1000時間放置後、発光させたところ、殆ど発光しなかった。

[0042]比較例2

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、実施例1と同様 20 に正孔注入層、発光層を形成した。その上に、Mg: A 1=8:2で混合した合金で膜厚200nmの電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10-6Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。この素子は、直流電圧5Vで190cd/miの黄緑色発光が得られ、発光効率は2.11m/Wであった。この素子を特に封止をせずに、初期輝度100cd/miで定電流駆動を続けたところ、500時間後には発光面の50%以上がダークスポットに覆われ、輝度も15cd/miまで低下してしまった。また、大気下に 301000時間放置後、発光させたところ、ダークスポットに覆われ発光は非常に弱かった。

【0043】比較例3

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、実施例1と同様に正孔注入層、発光層を形成した。その上に、Li:A 1=3:7で混合した合金で膜厚200nmの電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10°Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。この素子は、直流電圧5Vで220cd/m²の黄緑色発光が得られ、発光効率は2.71m/Wであった。この素子を特に封止をせずに、初期輝度100cd/m²で定電流駆動を続けたところ、500時間後には、輝度が10cd/m²以下まで低下してしまった。発光面にはダークスポットや輝度ムラが生じていた。大気下に1000時間放置後、発光させようとしたところ、全く発光しなかった。

【0044】比較例4

洗浄したITO電極付きガラス板上に、実施例24と同の陰極として使用することにより、高い発光輝度様に正孔注入層、発光層を形成した。その上に、Mg: 発光効率を維持しつつ、経時劣化の少ない長寿6Ag=10:1で混合した合金で膜厚200nmの電極 50 EL素子を容易に作製することが可能になった。

を形成して有機EL素子を得た。各層は10°Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。との素子は、直流電圧5Vで270cd/m²の黄緑色発光が得られ、発光効率は2.51m/Wであった。との素子を特に封止をせずに、初期輝度100cd/m²で定電流駆動を続けたところ、500時間後には発光面の70%以上がダークスポットに覆われ、輝度も10cd/m²以下までに低下してしまった。また、大気下に1000時間放置後、発光させようとしたところ、全く発光しなかった。

【0045】比較例5

洗浄した I TO電極付きガラス板上に、実施例1と同様 に正孔注入層、発光層を10-6Torrの真空中で、基 板温度室温の条件下で真空蒸着により形成した。その上 に、Mg: Ag = 10:1で予め形成された合金ターゲ ットを用いて、RFスパッタ法によりArガス下、0. 5kWの出力で膜厚200nmの電極を形成して有機E し素子を得た。との素子は、直流電圧5Vで280cd /m'の黄緑色発光が得られ、発光効率は2.41m/ ₩であった。この素子を特に封止をせずに、初期輝度1 00cd/m²で定電流駆動を続けたところ、500時 間後には発光面の50%以上がダークスポットに覆わ れ、輝度も20 c d/m' まで低下してしまった。ま た、大気下に1000時間放置後、発光させたところ、 ダークスポットに覆われ発光は非常に弱かった。 【0046】このように、従来の技術による有機EL素 子が、初期100cd/m²が500時間の継続駆動で 20 c d/m²以下に低下し、発光面がダークスポット で覆われたり、ムラが生じるのに対し、本発明の素子 は、50 c d/m²以上の輝度を保ち、ダークスポット の発生も殆どなかった。また、従来の技術による有機E し素子が、大気下に放置することにより、殆ど発光しな くなるのに対し、本発明の素子は十分な輝度の均一発光 を示した。以上の結果から、陰極に本発明で示される3 元合金を使用した有機EL索子は、発光輝度、発光効率 を低下させることなく、素子の駆動および保存における

【0047】本発明の有機EL素子は発光効率、発光輝度を維持しつつ、長寿命化を達成するものであり、併せて使用される発光材料、ドーピング材料、正孔輸送材料、電子輸送材料、増感剤、樹脂、電極材料等および素子作製方法を限定するものではない。

[0048]

40

長寿命化を達成した。

【発明の効果】本発明の有機EL素子は、陰極の劣化が抑制されたために、従来に比べて環境に対する経時安定性が高く、長寿命の有機EL素子を得ることができた。以上により、本発明で示した3元合金を、有機EL素子の陰極として使用することにより、高い発光輝度、高い発光効率を維持しつつ、経時劣化の少ない長寿命の有機EL素子を容易に作製することが可能になった。